

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成24年4月5日(2012.4.5)

【公開番号】特開2011-35209(P2011-35209A)

【公開日】平成23年2月17日(2011.2.17)

【年通号数】公開・登録公報2011-007

【出願番号】特願2009-180984(P2009-180984)

【国際特許分類】

H 01 L 27/04 (2006.01)

H 01 L 21/822 (2006.01)

G 11 C 16/06 (2006.01)

H 01 L 21/82 (2006.01)

H 03 K 19/00 (2006.01)

【F I】

H 01 L 27/04 G

G 11 C 17/00 6 3 2 Z

H 01 L 27/04 D

H 01 L 21/82 R

H 01 L 27/04 T

H 03 K 19/00 A

【手続補正書】

【提出日】平成24年2月17日(2012.2.17)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1電圧と第2電圧との間に並列に接続される複数の容量ユニットを備え、

前記複数の容量ユニットの各々は、

一方のノードが前記第1電圧に接続される容量素子と、

前記第2電圧と前記容量素子の他方のノードとの間に接続される容量遮断回路とを含み、

前記容量遮断回路は、前記容量素子から流入するリーク電流によって閾値電圧が変動する不揮発性メモリセルを有し、前記容量素子から流入するリーク電流が所定値を超える場合に、前記不揮発性メモリセルの閾値電圧の上昇によって前記容量素子から前記第2電圧へ流出するリーク電流を遮断する

半導体装置。